## 課題番号 2012S2-001



実験組織 研究代表者: 高橋 隆 (東北大学原子分子材料科学高等研究機構) 中山耕輔、菅原克明、相馬清吾、佐藤宇史(東北大)、吉田鉄平、藤森淳(東大理)、大川万里生、斉藤智彦(東理大理)、 小野寛太、組頭広志(PF物構研)

## 課題有効期間 平成24年4月 ~ 平成27年3月(3年間)

研究目的 本課題では、BL-28Aにおいて高分解能角度分解光電子分光法(ARPES)を用いてトポロジカル絶縁体やグラフェンなどを中心に、「ディラック電子系」と呼ばれている物質群の電子構造を精密に決定し、特異な量子現象の発現機構を解明することを目指す。フェルミ面、バンド分散、多体相互作用などの物性に関わるフェルミ準位近傍の基盤電子構造について、励起光や偏向の可変性を駆使することで電子状態の3次元性を解析し、ディラック電子系に重要な表面/バルクの区別も含めた電子構造の決定を行う。また、高温超伝導体や遷移金属化合物などのディラック電子系関連物質についても実験を行い、他のディラック電子系との相違点・類似点を明らかにする。





IV・NI半導体であるSnTelにおいて高分解能APPESを行い表面およびパルクパンド構造を決定した結果、これまで 報告されていたトポロジカル絶縁体が時間反転対称性に保護されたクラスであるのに対し、結晶の鏡映対称性 によりディッラク電子が保護された「トポロジカルクリスタル絶縁体」が実現していることを明らかにした。



、トポロジカル絶縁体のディラック電子は表面で発現する事が知られているが、(PbSe)<sub>5</sub>(Bi,Se<sub>3</sub>)<sub>3m</sub>においてはPbSe層とBi<sub>5</sub>Se<sub>3</sub>層の間の「界面」において発現するディッラク電子パンドを観測した。



[1] Y. Tanaka, Z. Ren, T. Sato, K. Nakayama, S. Souma, T. Takahashi, K. Segawa, and Y. Ando , Nature Phys. 8 (2012) 800.

- [2] K. Nakayama, K. Eto, Y. Tanaka, T. Sato, S. Souma, T. Takahashi, Kouji Segawa, and Yoichi Ando., Phys. Rev. Lett. 109 (2012) 236804.
- [3] S. Aizaki, T. Yoshida, K. Yoshimatsu, M. Takizawa, M. Minohara, S. Ideta, A. Fujimori, K. Gupta, P. Mahadevan, K. Horiba, H. Kumigashira, and M. Oshima., Phys. Rev. Lett. 109 (2012) 056401.
- [4] S. Ideta, T. Yoshida, I. Nishi, A. Fujimori, Y. Kotani, K. Ono, Y. Nakashima, S. Yamaichi, T. Sasagawa, M. Nakajima, K. Kihou, Y. Tomioka, C. H. Lee, A. Iyo, H. Eisaki, T. Ito, S. Uchida, and R. Arita, Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 107007.
- [5] T. Okuda, R. Kajimoto, M. Okawa, and T. Saitoh, Int. J. Mod. Phys. B 27, (2013) 1330002.